

PCT/JP03/13085
10.10.03

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

九月

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

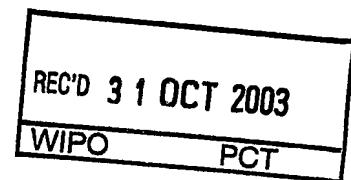
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年10月15日

出願番号
Application Number: 特願2002-301076

[ST. 10/C]: [JP2002-301076]

出願人
Applicant(s): 日本化薬株式会社
三光化学工業株式会社

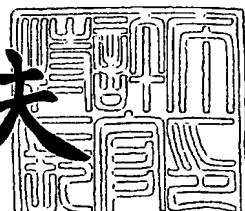


PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 9月26日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 KA57235B

【提出日】 平成14年10月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01M [REDACTED]

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県さいたま市北袋町2-336

【氏名】 濱田 雅裕

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県さいたま市上落合6-8-25

【氏名】 堀田 博樹

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県さいたま市三橋5-1857-6

【氏名】 岩渕 淳

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県比企郡滑川町大字山田1329-1

【氏名】 川上 省吾

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県高座郡寒川町一之宮8-20-1

【氏名】 山崎 武教

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県上尾市今泉 569

【氏名】 小林 久文

【特許出願人】

【識別番号】 000004086

【氏名又は名称】 日本化薬株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 390036881

【氏名又は名称】 三光化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100102668

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐伯 憲生

【電話番号】 03-5205-2521

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039251

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

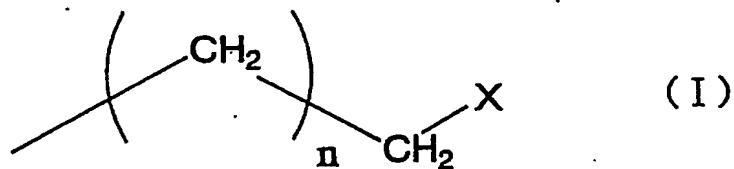
【書類名】明細書

【発明の名称】スルホアルキル基含有高分子の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記構造式で示される脱離基Xを含む側鎖(I)を有する高分子のXをアシルチオ基で置換し、さらに酸化することによりスルホン酸基にすることを特徴とするスルホアルキル基含有高分子の製造方法。

【化1】

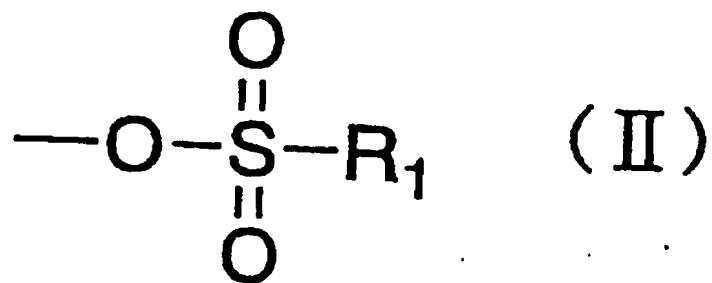


(式(I)中、Xは脱離基、nは0から6の整数を表す。)

【請求項2】n=0である請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】脱離基Xが、Cl, Br, I若しくは下記構造式(II)で示される置換基である請求項1もしくは2に記載のスルホアルキル基含有高分子の製造方法。

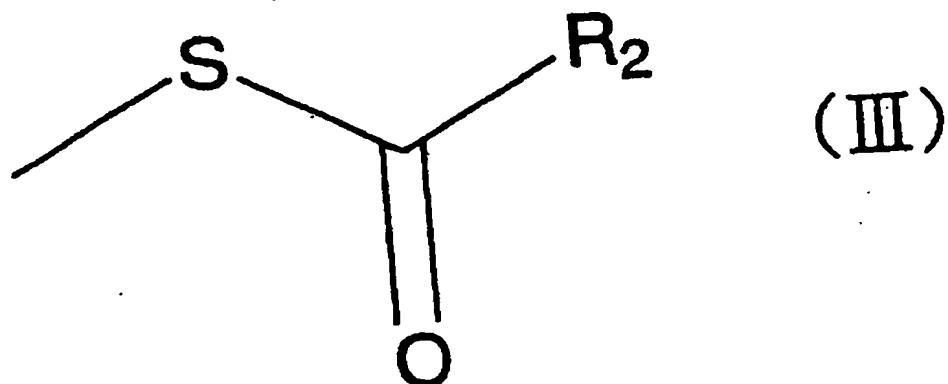
【化2】



(式(II)中、R1は炭素数が1から6のアルキル基、パーフルオロ(C1～C3)アルキル基又はアリール基を表す。)

【請求項4】アシルチオ基が下記構造式(III)で示される請求項1～3のいずれか一項に記載のスルホアルキル基含有高分子の製造方法。

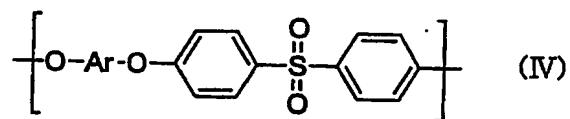
【化3】



(式 (III) 中, R₂ は炭素数が 1 から 6 のアルキル基, アリール基を表す。)

【請求項 5】高分子の主鎖骨格が下記構造式 (IV) で示されるポリスルホン骨格である請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載のスルホアルキル基含有高分子の製造方法。

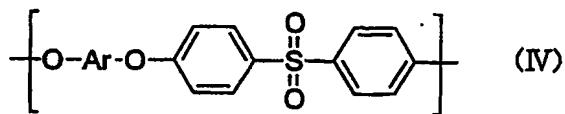
【化4】

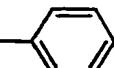
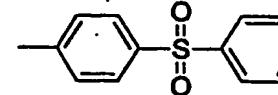
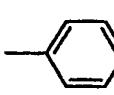


(式 (IV) 中, Ar は (A1), (A2), (A3) 又は (A4) を表す。)

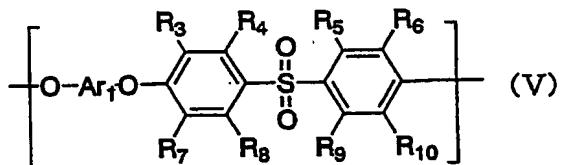
【請求項 6】下記構造式 (IV) で示されるポリスルホン系高分子の芳香環を (a) クロロメチル化し、(b) 次いで該クロル原子をアセチルチオ化し、さらに酸化することによりスルホン酸基にすることを特徴とする下記式 (V) で表されるスルホメチル化ポリスルホンの製造方法

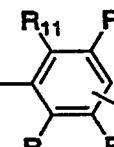
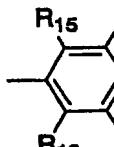
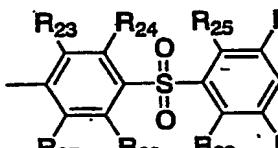
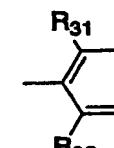
【化5】



(式(IV)中、 Ar は  (A1),  (A2)
 (A3) 又は  (A4)
 を表す。)

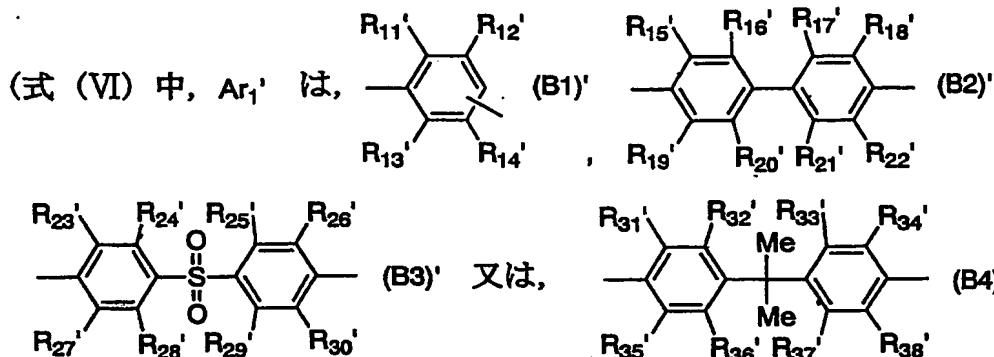
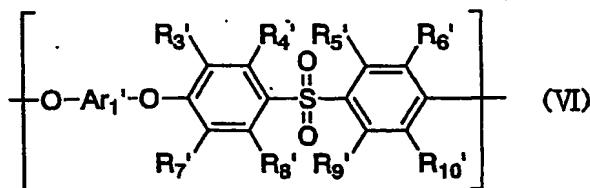
【化6】



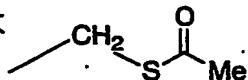
(式(V)中、 Ar_1 は  (B1),  (B2)
 (B3) 又は  (B4)
 を表し、 $\text{R}_3 \sim \text{R}_{38}$ は各々独立に水素原子もしくはスルホメチル基を表す。)

【請求項7】下記構造式(VI)で示されるアセチルチオメチル基含有ポリスルホン、

【化7】



を表し, R₃' ~ R₃₈' は各々独立に水素原子もしくは



を表す。)

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、スルホアルキル基をイオン交換基として有するイオン交換樹脂の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

高分子内にイオン交換基を有するイオン交換樹脂は、分離精製膜等の機能性高分子として有用であり、特にスルホン酸基を有するイオン交換樹脂は、スルホン酸のプロトン解離性の高さゆえに性能が優れていることから広く利用されている。特に近年、水電解槽や燃料電池の隔膜など、高分子固体電解質のイオン伝導体として応用しようという試みがなされている。

【0003】

高分子内にスルホン酸基を導入した樹脂としては、高分子中の芳香環を硫酸や

クロロ硫酸などのスルホン化剤でスルホン化したスルホン化樹脂が、簡便なため用いられてきた。例えば、スルホン化ポリエーテルケトン（特許文献1），スルホン化ポリスルホン（特許文献2），スルホン化ポリエーテルスルホン（特許文献2及び3）等が報告されている。しかし、これらの例のように、芳香環をスルホン化した場合、高温酸性条件下における安定性が必ずしもよくない。これは、芳香環のスルホン化反応が可逆反応であるため、脱スルホン化反応が起こるためだと考えられる。したがって、芳香環を直接スルホン化したイオン交換膜では、安定性が悪いため電解質として用いるには、長期安定性に問題がある。

【0004】

そこで、母剤となる高分子中にアルキル基を介してスルホン酸基を導入する方法がいくつか報告されている。例えば、ルイス酸とサルトンを用いて直接芳香族炭化水素系高分子の芳香環に炭素数3以上のスルホアルキル基を導入する方法（特許文献4，非特許文献1）または、ハロゲノメチル基、ハロゲノアルキル基を導入した後、ジメチルチオエーテルと亜硫酸ナトリウムや硫酸水素ナトリウムを用いてスルホン酸基を導入する方法（非特許文献1）などが報告されている。

しかしながら、サルトンを用いる方法では、サルトンの反応性が低いため、目的のスルホアルキル化物が極微量、もしくは全く得られないため、実用的な方法ではない。また、後者のハロゲノメチル基を亜硫酸ナトリウムでスルホン化する方法では、本来水系で行う反応であるが、ほとんどのハロゲノアルキル化ポリマーが水には全く溶けないため、ハロゲノアルキル基が全く反応しないか、もしくは一部しか反応せず、高分子の表面のみがスルホン化されたものしか得られず、充分なイオン交換能を有するスルホアルキル側鎖を有する高分子を得ることが困難であった。このため、高分子マトリックスの中まで充分にスルホン酸基を導入することが困難であった。

【0005】

【特許文献1】

特開平6-93114号公報

【特許文献2】

特開平9-245818号公報

【特許文献3】

特開平11-116679号公報

【特許文献4】

特開2002-110174号公報（第4～5頁、実施例1等）

【非特許文献1】

Macromol. Chem., Rapid Commun., 1, 1980, 297-302

【0006】**【発明が解決しようとする課題】**

上記のように、スルホアルキル基をイオン交換基として有するイオン交換樹脂は、母材の高分子にスルホアルキル基を直接入れる方法では非常に収率が悪く、また、脱離基を有するアルキル基を導入した後、その脱離基をスルホン酸基に変換する方法では脱離基、特に高分子マトリックス内の脱離基が充分にスルホン酸基に変換されないという問題あった。そこで本発明は脱離基含有アルキル基を導入した高分子において、該脱離基（高分子マトリックスの表面及び内部も含めた全ての脱離基）をほぼ定量的にスルホン酸基に変換することにより、高いイオン交換能を有する、スルホアルキル基含有高分子を、高収率でかつ安価に製造することを目的とするものである。

【0007】**【課題を解決するための手段】**

上記課題を解決するために、本発明者らは鋭意検討した結果、脱離基含有側鎖を有する高分子における脱離基を、アシルチオ基に変換した後スルホン酸基に変換することにより、上記目的を達成することができるを見出し、発明を完成させるに至った。

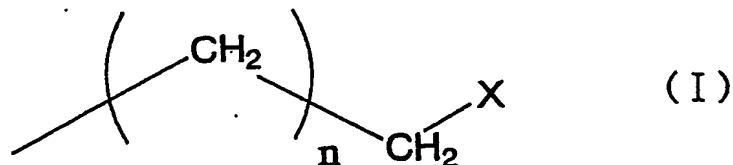
すなわち、本発明は、

【0008】

(1) 下記構造式で示される脱離基Xを含む側鎖(I)を有する高分子のXをアシルチオ基で置換し、さらに酸化することによりスルホン酸基にすることを特徴とするスルホアルキル基含有高分子の製造方法、

【0009】

【化8】



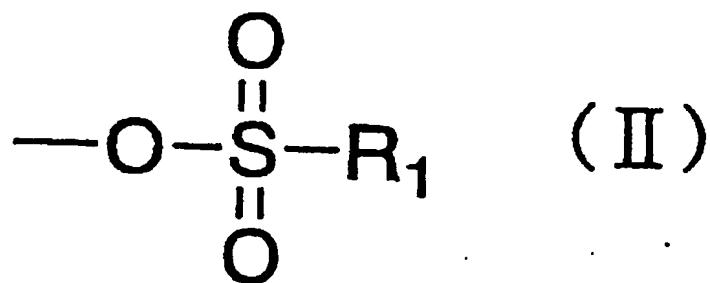
(式(I)中、Xは脱離基、nは0から6の整数を表す。)

【0010】

- (2) n=0である前項(1)に記載の製造方法、
- (3) 脱離基Xが、Cl, Br, I若しくは下記構造式(II)で示される置換基である前項(1)もしくは(2)に記載のスルホアルキル基含有高分子の製造方法、

【0011】

【化9】



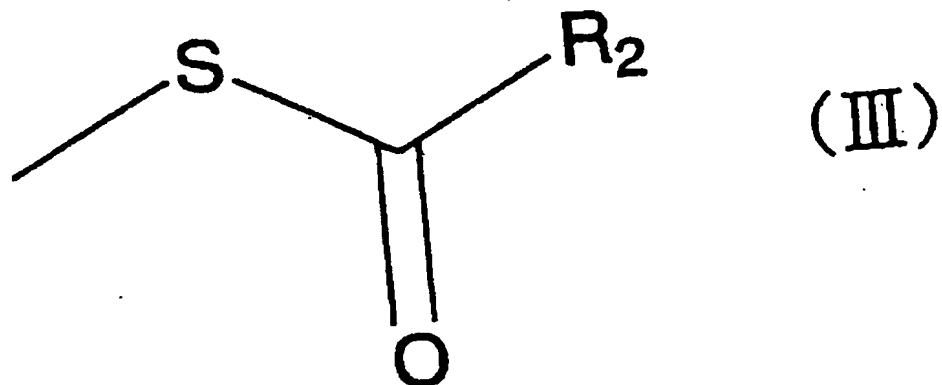
(式(II)中、R1は炭素数が1から6のアルキル基、パーフルオロ(C1～C3)アルキル基又はアリール基を表す。)

【0012】

- (4) アシルチオ基が下記構造式(III)で示される前項(1)～(3)のいずれか一項に記載のスルホアルキル基含有高分子の製造方法、

【0013】

【化10】



(式 (III) 中, R₂ は炭素数が 1 から 6 のアルキル基, アリール基を表す。)

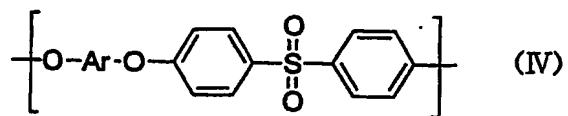
)

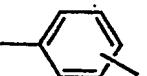
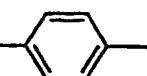
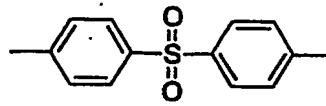
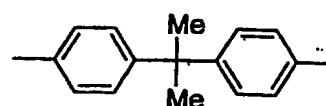
【0014】

(5) 高分子の主鎖骨格が下記構造式 (IV) で示されるポリスルホン骨格である前項 (1) ~ (4) のいずれか一項に記載のスルホアルキル基含有高分子の製造方法、

【0015】

【化11】



(式 (IV) 中, Ar は  (A1),  (A2)
 (A3) 又は  (A4)
 を表す。)

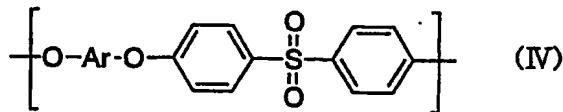
【0016】

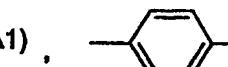
(6) 下記構造式 (IV) で示されるポリスルホン系高分子の芳香環を (a) クロロメチル化し、(b) 次いで該クロル原子をアセチルチオ化し、さらに酸化す

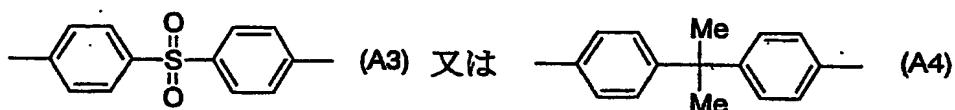
ることによりスルホン酸基にすることを特徴とする下記式(V)で表されるスルホメチル化ポリスルホンの製造方法、

【0017】

【化12】



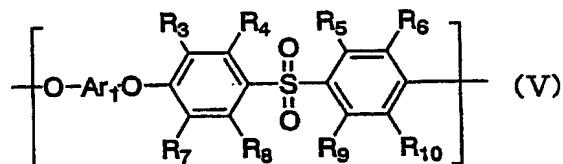
(式(IV)中, Arは  (A1),  (A2)

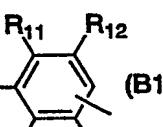
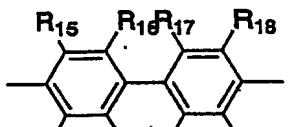


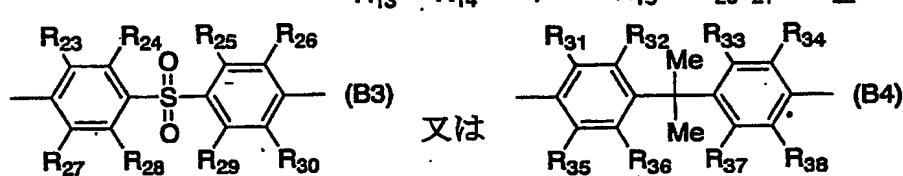
を表す。)

【0018】

【化13】



(式(V)中, Ar₁は  (B1) ,  (B2)



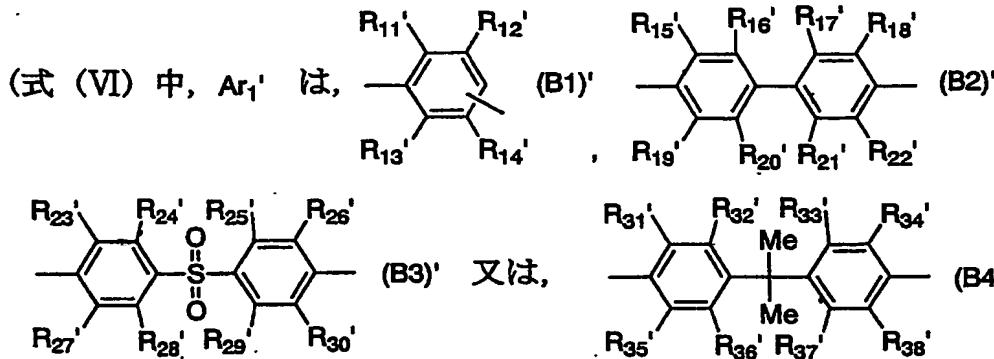
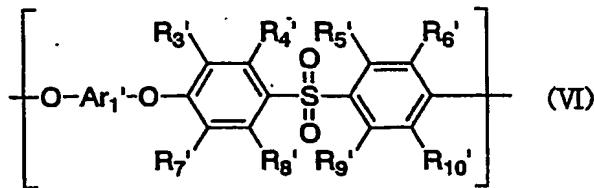
を表し, R₃~R₃₈は各々独立に水素原子もしくはスルホメチル基を表す。)

【0019】

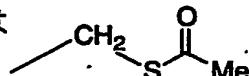
(7) スルホメチル化ポリスルホンの前駆体である下記構造式(VI)で示されるアセチルチオメチル基含有ポリスルホン、

【0020】

【化14】



を表し, $\text{R}_3' \sim \text{R}_{38}'$ は各々独立に水素原子もしくは



を表す。)

に関するものである。

【0021】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明において、スルホアルキル基含有高分子の母材となる高分子は、前記構造式 (I) で示される脱離基Xを有する側鎖を導入できる高分子であれば、いずれの高分子でもよい。耐久性の観点から、エンジニアリングプラスチックや架橋性高分子などの高耐久性高分子が好ましい。例えば、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミド、ポリイミダゾール、ポリオキサゾール、ポリスチレンージビニルベンゼン共重合体などの市販品や、これに順ずるもののが挙げられる。母材となる高分子としては、通常芳香族環、好ましくはベンゼン環を含む構造単位を有する芳香族炭化水素系高分子が好ましい。より好ましくは構造単位中に

芳香環を2～4個有し、かつ少なくとも2個の芳香環がスルホニル（-SO₂-）基を介して結合されている構造単位を有するポリスルホンが好ましい。そのようなポリスルホン化合物は例えば特開平11-116679等に開示されている。本発明においてより好ましいポリスルホンとしては前記構造式（IV）で示されるポリスルホンを挙げることができる。構造式（IV）で示されるポリスルホンの中ではArがフェニレン基またはビフェニレン基のものがより好ましい。

【0022】

これらの高分子（以下母材ということもある）に脱離基Xを有する側鎖を導入した高分子は公知であるか、公知方法に準じて、高分子反応を用いて母材となる高分子に脱離基を含む側鎖を導入することによって得ることができる。例えばステレンジビニルベンゼン等に該側鎖を導入した化合物は Macromol. Chem., Rapid Commun. 1, 297-302(1980) や Macromol. Chem. 184, 1585-1596(1983)等に開示されている。また、ポリスルホンに該側鎖を導入したものは例えば特開 2002-110174 等に開示されている。また、これらに開示されたされた方法に準じて、上記に開示されていない高分子に対して該側鎖を導入することにより、該側鎖を導入した高分子を得ることができる。より、詳しく、J. Org. Chem., 45, 1980, 2717-2719 に記載されたポリスチレンへの該側鎖を導入する方法に準じて、母材の高分子をn-ブチルリチウムテトラメチレンジアミン等のリチウム化剤で、リチオ化し、ジハライドなどの脱離基を含むアルキル化剤で側鎖部を導入する方法や、Makromol. Chem. 184, 1983, 1585-1596 記載のステレンジビニルベンゼンへの該側鎖の導入の方法に準じて、脱離基を有するアシル側鎖をフリーデルクラフツ反応で導入する方法（この場合は脱離基をスルホニル化した後カルボニル基の還元が必要）等が挙げられる。

【0023】

また、本発明において好ましい側鎖である、ハロゲノメチル基を該高分子の芳香環に導入する場合、芳香環のハロゲノメチル化反応は、特に制限なく公知の広範囲の反応が使用できる。例えばクロルメチル化反応の場合、クロロメチル化剤として、クロロメチルエーテル、1, 4-ビス（クロロメトキシ）ブタン、1-クロロメトキシ-4-クロロブタンなどクロロメトキシ置換低級アルカン

(クロロメトキシ以外に、更にクロルメチル化反応を阻害しない置換基を有してもよい)などを用い、触媒として塩化スズ、塩化亜鉛、塩化アルミニウム、塩化チタンなどのルイス酸やフッ化水素酸などを用いてクロロメチル化反応を行うことができる。溶媒には、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、ニトロベンゼンなどクロル置換脂肪族系もしくは芳香族系炭化水素溶媒または不活性な芳香族系炭化水素溶媒を用い、均一系で反応を行うことが好ましい。また、パラホルムアルデヒドと塩化水素もしくは臭化水素などを用いてハロゲノメチル化反応を行うこともできる。

【0024】

本発明で使用する脱離基Xを含む側鎖を導入した高分子において、該高分子への該側鎖の導入率は、適宜選択可能である。通常高分子の単位構造当たり該側鎖が0.1～2個（導入率10～200%という）程度導入されているものが使用され、0.1～1個（導入率10～100%）のものが好ましい。本発明の実施例記載の方法による場合、導入率20～60%程度のものを得ることができる。なお、導入率10%というのは単位構造10個当たりに該側鎖が1つ導入されていることを意味し、導入率100%は単位構造当たり1個の該側鎖が導入されていることを意味する。他の導入率の数値も同様な意味を示す。該高分子が芳香環を有するものである場合、該側鎖で置換された芳香環の1個あたりの該側鎖の置換個数は1個から2個、好ましくは1個である。なお、後述するように脱離基からスルホアルキル基への変換は100%定量的に行うことができるので、スルホアルキル基の高分子中への導入率はおおよそ原料として使用する高分子における脱離基Xを含む側鎖の導入率と同じである。

【0025】

前記構造式(I)で示される脱離基Xを含む側鎖を有する高分子において、脱離基Xはチオアシリ化剤、好ましくはチオアセチル化剤と反応するものならば、特に制限が無い。具体例を挙げると、脱離基Xとしては、C1、Br、I等のハロゲン原子若しくは前記構造式(II)で示される置換基等があげられる。構造式(II)におけるR₁としてはメチル基、エチル基、プロピル基、ヘキシル基などの炭素数1～6のアルキル基、トリフルオロメチル基等のパーフルオロ(C

1～C3) アルキル基、(C1～C3) アルキル又はハロゲンなどで置換されていてもよいフェニル基、ナフチル基などのアリール基を挙げることができる。構造式(I I)で示される脱離基の具体例としては、パラトルエンスルホニルオキシ基、メタンスルホニルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基などが挙げられる。本発明において好ましい脱離基はハロゲン原子であり、特に好ましいものはC1である。該側鎖において、脱離基Xと高分子母材をつなぐ側鎖部はポリメチレン基が好ましく、例えば、メチレン基、ジメチレン基、トリメチレン基、ヘキサメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基等の炭素数1～6のものであり、好ましくは1～3程度である。特に好ましいものはメチレン基である。脱離基Xを含む側鎖としてはハロゲノメチル基が好ましく、クロロメチル基はより好ましい。

【0026】

本発明のスルホアルキル基含有高分子の製造方法は、脱離基を含む側鎖を有する高分子において、脱離基をアシルチオ基で置換し、さらに酸化することによりスルホン酸基に変換し、スルホアルキル基を高分子中に導入することを特徴とする。中間体としてチオアシル化体を経由することにより、高分子マトリックスに置換している該側鎖の脱離基を、マトリックスの表面及び内部も含め、ほぼ定量的にスルホン酸基に変えることができる。

【0027】

脱離基Xのアシルチオ化は、該脱離基にアシルチオ化剤例えばチオ酢酸、チオプロパン酸、チオブタン酸、チオ安息香酸、チオトルエン酸などのチオカルボン酸、好ましく炭素数1～10のチオカルボン酸もしくはその塩、好ましくはナトリウム塩やカリウム塩などアルカリ金属塩を作用させることによって定量的に行うことができる。用いるアシルチオ化剤の量は、脱離基Xに対して当量もしくは少過剰用いれば十分である。

【0028】

脱離基Xのアシルチオ化の反応温度は、高分子の種類、脱離基の種類、アシルチオ化剤等の種類などで異なるので一概には言えないが0℃～100℃程度の範囲で、適宜選択されよく、一般的には10℃～90℃程度ある。アシルチオ化剤

の種類や高分子の種類等により室温でよく、また、場合により反応を完全に進行させるために80℃程度に加温してもよい。

【0029】

脱離基Xのアシルチオ化反応の溶媒としては、N-メチルピロリドン、N,N-ジメチルホルムアムド、N,N-ジメチルアセトアミドなどの非プロトン性極性溶媒を広範囲に用いることができる。

【0030】

アシルチオ体の酸化には、有機もしくは無機過酸化物、例えば過酸化水素水や過酢酸等の酸化剤を広範囲に用いることができる。酸化剤の量は、当量もしくは少過剰用いればよく、場合によってはアシルチオ基に対して5当量以上用いる必要がある。

【0031】

アシルチオ基の酸化の反応温度は、通常20℃～90℃程度であり、40℃から80℃が好ましく、反応中は温度をできるだけ一定に保つことが好ましい。

【0032】

アシルチオ基の酸化反応の溶媒としては、酢酸やジクロロメタンなど通常酸化反応に用いる溶媒を広範囲に用いることができる。

【0033】

本発明の製法において、脱離基Xからスルホアルキル基への変換は100%定量的に行うことができるので、得られたスルホアルキル基含有高分子のイオン交換当量重量(EW)は、前駆体の脱離基の量を調整することで制御できる。したがって、原料化合物として使用する高分子における脱離基を含む側鎖の含量を適宜選択することにより、任意のイオン交換当量を有するスルホアルキル基含有高分子の合成が可能である。

【0034】

本発明の製造方法においては、スルホアルキル基含有高分子を製造する際に、通常の高分子に使用される可塑剤、安定剤、離型剤などの添加剤を本発明の目的に反しない範囲内で使用できる。

【0035】

【実施例】

以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0036】

(滴定法によるイオン交換容量の測定)

樹脂Wgを1規定の水酸化ナトリウム水溶液10mlに1晩浸漬してイオン交換を行った後、ろ過で樹脂を取り除いた。水溶液2mlをホールピペットで取って、自動滴定装置(HIRANUMA, COM-555)を用いて0.1規定の塩酸で滴定を行った。1規定の水酸化ナトリウム2mlを滴定したときの滴定量をQ0ml、イオン交換後の水溶液2mlを滴定したときの滴定量をQwm1として、次式でイオン交換容量を求めた。なお、式中Fは水酸化ナトリウム水溶液の力値を示す。

$$\text{イオン交換容量 (meq/g)} = (Q_0 - Q_w) \times 0.1 \times F \times 5 / W$$

【0037】**実施例1**

スルホメチル化ポリフェニレンエーテルスルホン(式(V)でAr₁=B2)の合成；

攪拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた500mlの4ツ口丸底フラスコに、ポリフェニレンエーテルスルホン(Aldrich製、商品名: Polyphenylsulfone) 30g、テトラクロロエタン250mlを入れ、さらにクロロメチルメチルエーテル50mlを加えた後、無水塩化スズ(IV)1mlとテトラクロロエタン20mlの混合溶液を滴下し、80℃に加熱して90分加熱攪拌した。次いで、メタノール1l中に溶液を落とし、ポリマーを析出させた。析出させた沈殿をミキサーで粉碎し、酸成分が抜けるまでメタノールで洗浄し、加熱乾燥してクロロメチル化ポリフェニレンエーテルスルホン(式(VI)でAr_{1'}=B2') 34gを得た。得られた化合物はNMRにより同定することができ、クロロメチル基のメチレンプロトンのケミカルシフトは4.64ppmであった。また、クロロメチル基の導入率はNMRのプロトン積分比より算出することができ、36%だった。

【0038】

次に、得られたクロロメチル化ポリフェニレンエーテルスルホンを攪拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた1000mlの4ツ口丸底フラスコに入れ、N-メチルピロリドン600mlを加えた。これに、チオ酢酸カリウム9gとNMP50mlの溶液を加え、80℃に加熱し3時間加熱攪拌した。次いで、水1l中に溶液を落とし、ポリマーを析出させた。析出させた沈殿をミキサーで粉碎し、水で洗浄した後、加熱乾燥してアセチルチオ化ポリフェニレンエーテルスルホン31gを得た。

【0039】

次に、得られたアセチルチオ化ポリフェニレンエーテルスルホン20gを攪拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた500mlの4ツ口丸底フラスコに入れ、さらに酢酸300ml加えた。過酸化水素水20mlを加え、45℃に加熱し4時間加熱攪拌した。次いで、6規定の水酸化ナトリウム水溶液1lに、冷却しながら反応溶液を加えしばらく攪拌した。ポリマーをろ過し、アルカリ成分が抜けるまで水で洗浄した。その後、1規定の塩酸300mlにポリマーを加え、しばらく攪拌した。ポリマーをろ過し、酸成分が抜けるまで水で洗浄し、減圧乾燥することで、スルホメチル化ポリフェニレンエーテルスルホン20gを得た（クロルメチル化体からの収率、約91%）。NMRのメチレンプロトンのケミカルシフトが3.78ppmにシフトしていることにより、スルホメチル基の存在を確認した。また、滴定法によりイオン交換容量を測定したところ、0.83meq/gであった。

【0040】

実施例2

スルホメチル化ポリエーテルスルホン（式（V）でAr₁=B3）の合成；攪拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた500mlの4ツ口丸底フラスコに、ポリエーテルスルホン（商品名；スミカエクセルPES7600p、住友化学工業（株）製）23g、ニトロベンゼン330mlを入れ、さらにクロロメチルメチルエーテル40gと無水塩化スズ（IV）7.8gの混合溶液を滴下し、50℃に加熱して8時間加熱攪拌した。次いで、メタノール1l

中に溶液を落とし、ポリマーを析出させた。析出させた沈殿をミキサーで粉碎し、酸成分が抜けるまでメタノールで洗浄し、加熱乾燥してクロロメチル化ポリエーテルスルホン（式（V I）で $\text{Ar}_1' = \text{B}3'$ ）25 gを得た。得られた化合物はNMRにより同定することができ、クロロメチル基のメチレンプロトンのケミカルシフトは4.8 ppmであった。また、クロロメチル基の導入率はNMRのプロトン積分比より算出することができ、34%だった。

【0041】

次に、得られたクロロメチル化ポリエーテルスルホン25 gを搅拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた1000mlの4ツ口丸底フラスコに入れ、N-メチルピロリドン375mlを加えた。これに、搅拌しながらチオ酢酸カリウム4.3 gを添加し、室温で1時間搅拌した。次いで、水3l中に溶液を落とし、ポリマーを析出させた。析出させた沈殿をミキサーで粉碎し、水で洗浄した後、加熱乾燥してアセチルチオ化ポリポリエーテルスルホン24 gを得た。

【0042】

次に、得られたアセチルチオ化ポリエーテルスルホン24 gを搅拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた500mlの4ツ口丸底フラスコに入れ、さらに酢酸350ml加えた。30%過酸化水素水18mlを加え、70℃に加熱し8時間加熱搅拌した。内容物をろ過回収して、酸成分が抜けるまで水で洗浄し、減圧乾燥することで、スルホメチル化ポリエーテルスルホン23 gを得た（クロルメチル化体からの収率 約92%）。NMRのメチレンプロトンのケミカルシフトが3.85 ppmにシフトしていることにより、スルホメチル基の存在を確認した。また、滴定法によりイオン交換容量を測定したところ、1.29 meq/gであった。

【0043】

実施例3

スルホメチル化ポリスルホン（式（V）で $\text{Ar}=\text{B}4$ ）の合成；

搅拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた500mlの4ツ口丸底フラスコに、ポリスルホン（アモコ製、商品名ユーデル、P-1700NT

11) 31 g、テトラクロロエタン300m1を入れ、さらにクロロメチルメチルエーテル18 gを加えた後、無水塩化スズ(IV)1m1とテトラクロロエタン20m1の混合溶液を滴下し、60℃に加熱して120分加熱攪拌した。次いで、メタノール1l中に溶液を落とし、ポリマーを析出させた。析出させた沈殿をミキサーで粉碎し、酸成分が抜けるまでメタノールで洗浄し、加熱乾燥してクロロメチル化ポリスルホン(式(VI)で $\text{Ar}_1'=\text{B}_4'$)33 gを得た。得られた化合物はNMRにより同定することができ、クロロメチル基のメチレンプロトンのケミカルシフトは4.53 ppmであった。また、クロロメチル基の導入率はNMRのプロトン積分比より算出することができ、38%だった。

【0044】

次に、得られたクロロメチル化ポリスルホン15 gを攪拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた500m1の4ツ口丸底フラスコに入れ、N-メチルピロリドン200m1を加えた。これに、チオ酢酸カリウム4.6 gを加え、80℃に加熱し3時間加熱攪拌した。次いで、水1l中に溶液を落とし、ポリマーを析出させた。析出させた沈殿をミキサーで粉碎し、水で洗浄した後、加熱乾燥してアセチルチオ化ポリスルホン17 gを得た。

【0045】

次に、得られたアセチルチオ化ポリスルホン17 gを攪拌機、温度計、塩化カルシウム管を接続した還流冷却器をつけた500m1の4ツ口丸底フラスコに入れ、さらに酢酸200m1加えた。過酸化水素水50m1を加え、65℃に加熱し4時間加熱攪拌した。次いで、6規定の水酸化ナトリウム水溶液1lに、冷却しながら反応溶液を加えしばらく攪拌した。ポリマーをろ過し、アルカリ成分が抜けるまで水で洗浄した。その後、1規定の塩酸300m1にポリマーを加え、しばらく攪拌した。ポリマーをろ過し、酸成分が抜けるまで水で洗浄し、減圧乾燥することで、スルホメチル化ポリスルホン15 gを得た(クロルメチル化体からの収率 約99%)。NMRのメチレンプロトンのケミカルシフトが4.06 ppmにシフトしていることにより、スルホメチル基の存在を確認した。また、滴定法によりイオン交換容量を測定したところ、0.80 meq/gであった。

【0046】

比較例 1

実施例2で合成したクロロメチル化ポリエーテルスルホン20gを攪拌機、温度計、還流冷却器をつけた1000mlの4ツ口丸底フラスコに入れ、水500mlを加えた。これに、亜硫酸水素ナトリウム25gを加え、24時間加熱還流した。次いで、ポリマーをろ過し、1N塩酸、水で洗浄した後、加熱乾燥してスルホメチル化ポリエーテルスルホン19gを得た。NMRで確認したところ、クロロメチル基はほとんど反応していなかった。また、イオン交換能もほとんど示さなかった。

【0047】

比較例 2

実施例3で合成したクロロメチル化ポリスルホン0.5gを攪拌機、温度計、還流冷却器をつけた100mlの4ツ口丸底フラスコに入れ、水40mlを加えた。これに、亜硫酸ナトリウム15gを加え、80℃に加熱し8時間加熱還流させた。次いで、ポリマーをろ過し、1N塩酸、水で洗浄した後、加熱乾燥してスルホメチル化ポリスルホン0.5gを得た。NMRで確認したところ、クロロメチル基はほとんど反応していなかった。また、イオン交換能もほとんど示さなかった。

【0048】

比較例 3

実施例3で合成したクロロメチル化ポリスルホン1gを攪拌機、温度計、還流冷却器をつけた100mlの4ツ口丸底フラスコに入れ、クロロホルム20mlを加え溶解させた。これに、硫酸ナトリウム0.7gを水20mlに溶かした溶液とテトラブチルアンモニウムプロミド50mgを加え、70℃で3時間、2相系で加熱攪拌した。次いで、ポリマーをろ過し、1N塩酸、水で洗浄した後、加熱乾燥してスルホメチル化ポリスルホン0.5gを得た。NMRで確認したところ、クロロメチル基はほとんど反応していなかった。また、イオン交換能もほとんど示さなかった。

【0049】

【発明の効果】

以上説明してきたように、本発明方法によれば、脱離基を含む側鎖を含有する高分子の側鎖上の脱離基を、ほぼ定量的にスルホン酸基に変えることができるもので、高分子マトリックスの表面ばかりでなく内部における側鎖上の脱離基もスルホン酸基に変えることができ、スルホアルキル基をイオン交換基として有するイオン交換能の高いイオン交換樹脂を安価に製造しうるものである。

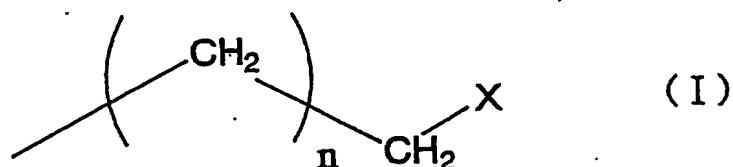
【書類名】要約書

【要約】

【課題】スルホアルキル基をイオン交換基として有するイオン交換樹脂の製造方法、特に、高分子マトリックスの中まで十分にスルホアルキル基を導入することが可能なスルホン酸基含有高分子の製造法の提供。

【解決手段】下記構造式で示される脱離基Xを含む側鎖(I)を有する高分子のXをアシルチオ基で置換し、さらに酸化することによりスルホン酸基にすることを特徴とするスルホアルキル基含有高分子の製造方法。

【化1】



(式(I)中、Xは脱離基、nは0から6の整数を表す。)

特願2002-301076

出願人履歴情報

識別番号 [000004086]

1. 変更年月日 1990年 8月 9日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都千代田区富士見1丁目11番2号
氏名 日本化薬株式会社

特願 2002-301076

出願人履歴情報

識別番号 [390036881]

1. 変更年月日 1990年12月10日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区霞が関3-2-6
氏 名 三光化学工業株式会社

2. 変更年月日 2000年12月 5日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都中央区日本橋本町3丁目8番5号
氏 名 三光化学工業株式会社